

シリコンNチャンネルMOS形電界効果トランジスタ  
( $\pi$ -MOSII)

# 2SK894

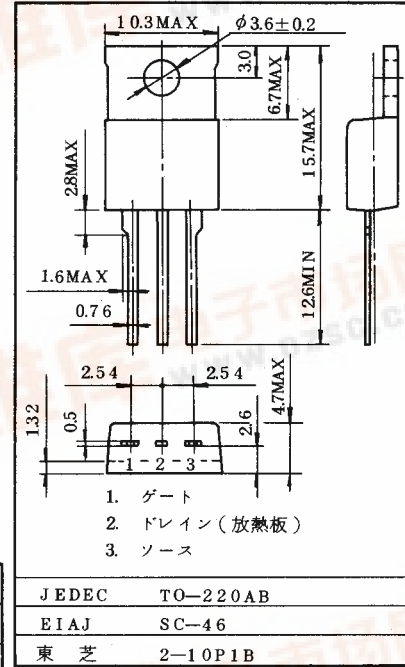
通信工業用  
単位: mm

- 高速, 高電圧スイッチング用
- スwitchングレギュレータ, DC-DCコンバータ用
- モータドライブ用

- ・ オン抵抗が低い :  $R_{DS(ON)} = 0.65\Omega$  (標準)
- ・ 順方向伝達アドミタンスが高い :  $|Y_{fs}| = 65S$  (標準)
- ・ 漏れ電流が低い :  $I_{DSS} = 300\mu A$  (最大) ( $V_{DS} = 500V$ )
- ・ 取扱いが簡単な, エンハンスメントタイプです  
:  $V_{th} = 15 \sim 35V$  ( $V_{DS} = 10V, I_D = 1mA$ )

最大定格 ( $T_a = 25^\circ C$ ).

項 目	記 号	定 格	単 位
ドレイン・ソース間電圧	$V_{DSS}$	500	V
ドレイン・ゲート間電圧 ( $R_{GS} = 20k\Omega$ )	$V_{DGR}$	500	V
ゲート・ソース間電圧	$V_{GSS}$	$\pm 20$	V
ドレイン電流	DC	$I_D$	8
	パルス	$I_{DP}$	32
許容損失 ( $T_c = 25^\circ C$ )	$P_D$	125	W
チャンネル温度	$T_{ch}$	150	$^\circ C$
保存温度	$T_{stg}$	$-55 \sim 150$	$^\circ C$



熱抵抗特性

項 目	記 号	最 大	単 位
チャンネル・ケース間熱抵抗	$R_{th(ch-c)}$	1.0	$^\circ C/W$
チャンネル・外気間熱抵抗	$R_{th(ch-a)}$	80	$^\circ C/W$

この製品はMOS構造ですので取扱いの際には静電気にご注意ください。

## 2SK894

電気的特性 (Ta = 25°C)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位	
ゲート漏れ電流	$I_{GSS}$	$V_{GS} = \pm 20V, V_{DS} = 0V$	—	—	$\pm 100$	nA	
ドレインシャ断電流	$I_{DSS}$	$V_{DS} = 500V, V_{GS} = 0V$	—	—	300	$\mu A$	
ドレイン・ソース間降伏電圧	$V(BR)_{DSS}$	$I_D = 10mA, V_{GS} = 0V$	500	—	—	V	
ゲートしきい値電圧	$V_{th}$	$V_{DS} = 10V, I_D = 1mA$	1.5	—	3.5	V	
ドレイン・ソース間オン抵抗	$R_{DS(ON)}$	$I_D = 4A, V_{GS} = 10V$	—	0.65	0.85	$\Omega$	
順方向伝達アドミタンス	$ Y_{fs} $	$V_{DS} = 10V, I_D = 4A$	3.5	6.5	—	S	
入力容量	$C_{iss}$	$V_{DS} = 10V, V_{GS} = 0V, f = 1MHz$	—	1300	2000	pF	
帰還容量	$C_{rss}$		—	330	500		
出力容量	$C_{oss}$		—	640	900		
スイッチング時	上昇時間	$t_r$		—	7	15	ns
	ターンオン時間	$t_{on}$		—	25	50	
	下降時間	$t_f$		—	15	30	
	ターンオフ時間	$t_{off}$		—	60	120	
ゲート入力電荷量	$Q_g$	$V_{DD} = 400V, V_{GS} = 10V, I_D = 10A$	—	42	60	nC	
ゲート・ソース間電荷量	$Q_{gs}$		—	20	—		
ゲート・ドレイン間電荷量	$Q_{gd}$		—	22	—		

ソース・ドレイン間ダイオードの定格と特性 (Ta = 25°C)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
ドレイン逆電流 (連続)	$I_{DR}$	—	—	—	8	A
ドレイン逆電流 (パルス)	$I_{DRP}$	—	—	—	32	A
ダイオード順電圧	$V_{DSF}$	$I_{DR} = 8A, V_{GS} = 0V$	—	—	-2.0	V
逆回復時間	$t_{rr}$	$I_{DR} = 8A, V_{GS} = 0V$	—	350	—	ns
逆回復電荷量	$Q_{rr}$	$dI_{DR}/dt = 100A/\mu s$	—	3.0	—	$\mu C$